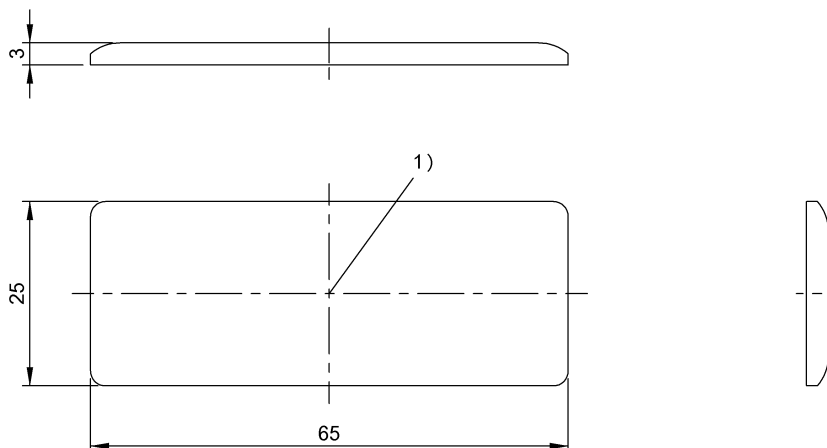


Высокие частоты (13,56 МГц)

BIS M-115-03/A-SA2

Код заказа: BIS00RZ

BALLUFF



1) Активная поверхность



Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,03 с
Длительность хранения данных/ лет	≥ 10
Структура памяти	28 × 4 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 50 °C: 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура хранения	-30...60 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/ запись	112 Byte
Серийный номер UID, только для считывания	8 Byte
Тип памяти	EEPROM

General data

EN 55011	Гр. 1, класс A
EN 55022	Gr.1,KI.B
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
Форма антенны	прямоугольн.

Material

Материал корпуса	Эпоксидная смола - стекловолокно ПВХ
------------------	--

Mechanical data

Размеры	25 x 3 x 65 мм
Снаряженная масса	7.00 g

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-115-03/A-SA2
Код заказа: BIS00RZ

BALLUFF

Remarks

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Указание времени, включая контроль данных.

Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.

Способ монтажа на ровной стали

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.